

# 3倍波水晶発振用 低位相ノイズ KH9705ALy

## 概要

本 IC は、発振用アンプ及びスリーステートバッファより構成されます。帰還抵抗  $R_f$  の温度特性を発振用アンプと合せる事により、広い動作電圧範囲（2.7~5.5V）を実現しました。

ESD、Latch-up試験には信頼性の高い Automotive Electronics Council の半導体規格 (AEC-Q100) を採用。

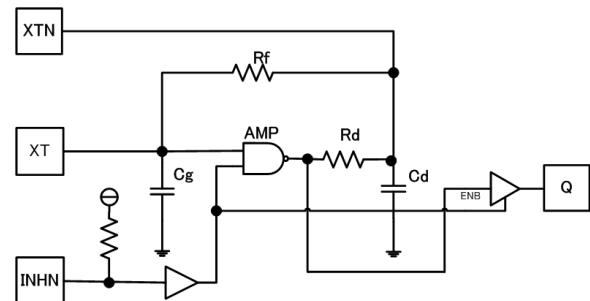
## 特長

動作電圧	$f_0 \leq 107\text{MHz}$	2.25 ~ 3.6V
	$f_0 \leq 133\text{MHz}$	2.7 ~ 5.5V
動作温度	-40 ~ 85°C	
スタンバイモード INHN="L"	Q 出力 "Hi-z"	
	発振停止	
INHN 入力レベル	C-MOS	
Q 出力レベル	C-MOS	
Q 出力電流	8mA(VDD=2.7V)	
Q 出力負荷	2.25V ≤ VDD ≤ 2.75V	30pF ( $\leq 107\text{MHz}$ )
		50pF ( $\leq 67\text{MHz}$ )
	2.7V ≤ VDD ≤ 3.6V	15pF ( $\leq 125\text{MHz}$ )
		30pF ( $\leq 107\text{MHz}$ )
		50pF ( $\leq 70\text{MHz}$ )
	4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V	15pF ( $\leq 125\text{MHz}$ )
		30pF ( $\leq 100\text{MHz}$ )
		50pF ( $\leq 50\text{MHz}$ )

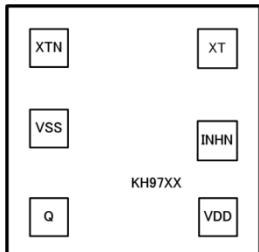
## シリーズ構成

バージョン	発振周波数(3倍波)	
	2.25 ~ 3.6V	2.7 ~ 5.5V
KH9705ALA	30 ~ 40MHz	30 ~ 50MHz
KH9705ALB	40 ~ 55MHz	50 ~ 70MHz
KH9705ALC	55 ~ 75MHz	65 ~ 100MHz
KH9705ALD	75 ~ 100MHz	95 ~ 125MHz
KH9705ALE	90 ~ 107MHz	100 ~ 133MHz

## Block 図



## PAD 配置図



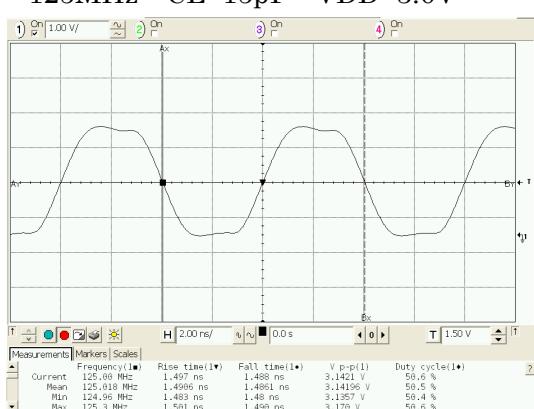
チップサイズ	0.80×0.80mm
パッドサイズ	90×90μm
チップ厚	200±20μm
チップ裏面	VSSレベル

## 信頼性

	試験モデル	耐性値
ESD	HBM	>4000V
	MM	>400V
	FI-CDM	>1000V
Latch-up	電流注入法	>200mA
	電源過電圧法	>8.3V

## 出力波形

125MHz CL=15pF VDD=3.0V



注) 本資料は簡易データシートです。正式版データシートをご希望の方は弊社へお問い合わせください。